产品特性 FEATURES

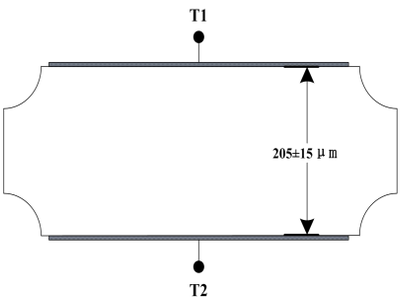
芯片特征：NPNPN 五层结构的硅双向器件，过电压触发导通，电压一致性好，高可靠性，三层金属电极。

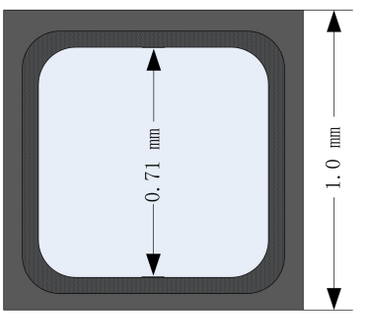
芯片电特性 CHIP ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tc=25℃)

参数 Parameter	测试条件 Test Conditions	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
不动作电压 V_{RM}	I_{RM}=1μA	6			V
最高限制电压 V_{BO}	1KV/μs	7		14.9	V
通态电压 V_{TM}	I_T=2.2A			3	V
维持电流 I_H	10A，10/1000μs	10		50	mA
极间电容 C	2V，1MHz			10	pF
转折电流 I_S				800	mA
脉冲突波测试 Surge pulse current	10/1000μs±5 Times				A
	2/10μs ±1 Times				A
	8/20μs ±1 Times				A
	10/700μs	1500			V
结温	Tj	-55		125	℃

芯片信息确认 CHIP INFORMATION CONFIRM

芯片工艺 Wafer technique	内台面	
圆片尺寸 Wafer Size	■Φ4inch □Φ3inch □其它 Other_____	
芯片厚度 Chip Thickness	（205±15）μm	
芯片尺寸 Chip Size	1.0mm×1.0mm	
有效图形数 Effective number	7069 dies/wafer	
金属 Metal	正面 Front	Ti+Ni+Ag
	背面 Back	Ti+Ni+Ag
键合区面积 Bond Area	**710μm *710μm**	





NOTICE

Leiditech reserves the right to make modifications,enhancements,improvements,corrections or other changes without further notice to any product herein. Leiditech does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein.

Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd.
Email: sale1@leiditech.com
Tel : +86- 021 50828806
Fax : +86- 021 50477059